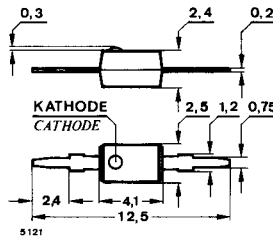


## Silizium-Epitaxial-Planar-Diode Silicon epitaxial planar diode

**Anwendungen:** Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

**Applications:** Band selector in VHF-tuners

**Abmessungen in mm  
Dimensions in mm**



Kunststoffgehäuse  
Plastic Case  
SOD 23  
Gewicht · Weight  
max. 0,1 g

### Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	$U_R$	35	V
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	100	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$t_j$	100	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	$t_{stg}$	-55...+100	°C

### Wärmewiderstand Thermal resistance

	Min.	Typ.	Max.
Sperrschicht-Umgebung Junction ambient $l = 4 \text{ mm}, t_L = \text{konstant}$ constant			400 °C/W
			$R_{thJA}$

# BA 182

## Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$t_j = 25^\circ\text{C}$ , falls nicht anders angegeben  
unless otherwise specified

Durchlaßspannung  
Forward voltage

$I_F = 100\text{ mA}$

$U_F^{(1)}$

1,2

V

Sperrstrom  
Reverse current

$U_R = 20\text{ V}$

$U_R = 20\text{ V}, t_j = 60^\circ\text{C}$

$I_R$

100

nA

$I_R$

1

$\mu\text{A}$

Durchbruchspannung  
Breakdown voltage

$I_R = 10\ \mu\text{A}$

$U_{(BR)}$

35

V

Diodenkapazität  
Diode capacitance

$f = \text{MHz}, U_R = 1\text{ V}$

$U_R = 20\text{ V}$

$C_D$

2,1

pF

$C_D$

0,8

1,25

pF

Differentieller Durchlaßwiderstand  
Differential forward resistance

$I_F = 5\text{ mA}, f = 200\text{ MHz}$

$r_f$

0,5

0,7

$\Omega$

